



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100830000  
2010 年 9 月 2 日

## お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタムドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 

### HPA SEMEFAB社サイト製造 一部製品 前処理プロセス変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての一次予定の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input checked="" type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input checked="" type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	HPA SEMEFAB 社サイト製造 一部製品 前処理プロセス変更 現行 : 前処理プロセス一部変更 未対応 変更後: 前処理プロセス一部変更 対応			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2011 年 2 月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) SEMEFAB社(スコットランド)サイト製造 一部製品について、プロセス最適化及び生産性向上の為に、前処理プロセス一部を変更する予定です。プロセス変更については下記を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理プロセス	一部変更未対応	一部変更対応

	現行	変更後	変更理由
Process	902 process	Create 904, a sub group of 902	To have both oxide and Nitride caps
Process Sequence	Process sequence for Nitride capacitor only	Process sequence for Nitride and Oxide capacitors	Devices need to have both capacitors
Passivation	ASM passivation dep (14KA)	Oxide (5kA) LTO +OxyNitride (9kA) Novellus	To fix the surface charges

理由: プロセス最適化及び生産性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
ACF2101BU	ACF2101BUE4	IVC102U	IVC102U/2K5	IVC102U/2K5G4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010年9月	終了	2010年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ACF2101BU		Die Size (mm):	3.35 X 3.99
Wafer Fab Site:	SEMEFAB		Wafer Fab Process:	SEMEFAB 904
Die Protective Coating:	PECVD, Oxide (5kA)+OxyNitride (9kA)		Metallization:	AlSi
MSL:	JEDEC L-3/260C		-	-
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs			77
Electrical Char	-			10
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs			77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hours			77
**Autoclave	121C, 96 Hours			77
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cycles			77
ESD HBM	3 units/voltage, 500V, 1000V, 1500V, 2000V			12
ESD CDM	3 units/voltage, 200V, 500V			6
Latchup	-			6
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification			Per Spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C			12
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010年9月	終了	2010年12月	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	IVC102U		Die Size (mm):	1.8542 X 3.302	
Wafer Fab Site:	SEMEFAB		Wafer Fab Process:	SEMEFAB 904	
Die Protective Coating:	PECVD, Oxide (5kA)+OxyNitride (9kA)		Metallization:	AlSi	
MSL:	JEDEC L-3/260C		-	-	
信頼性試験計画					
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size	
				Lot#1	Lot#2
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs			77	-
Electrical Char.	Full Temperature			15	15
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs			77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hours			77	77
**Autoclave	121C, 96 Hours			77	77
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cycles			77	77
ESD HBM	3 units/voltage, 500V, 1000V, 1500V, 2000V			12	-
ESD CDM	3 units/voltage, 200V, 500V			6	-
Latchup	-			6	-
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification			Per Spec	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C			12	-
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C					